Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics of RAS



# АКУСТОЭЛЕКТРОННО-СПИНТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ГЕНЕРАЦИИ И ПРИЕМА ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

іфти

### <sup>1,2</sup>П.А. Попов, <sup>1,3</sup><u>А.Р. Сафин</u>, <sup>1,2</sup>С.А. Никитов,

<sup>1</sup>Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН

<sup>2</sup>Московский физико-технический институт (государственный университет)

<sup>3</sup>Национальный исследовательский университет «МЭИ»

# СОДЕРЖАНИЕ

- МОТИВАЦИЯ
- ОСНОВЫ СПИНТРОНИКИ И СТРЕЙНТРОНИКИ
- Эффекты GMR, TMR, STT, SOT, Spin-Pumping
- Магнитоэлектрические эффекты
- Магнонная стрейнтроника
- АНТИФЕРРОМАГНИТНЫЕ ОСЦИЛЛЯТОРЫ, ДЕТЕКТОРЫ И ТЕРАГЕРЦОВАЯ СПИНТРОНИКА
- Материалы для АФМ-спинтроники
- > Автогенераторы. Осцилляторы с внешним возбуждением
- Детекторы терагерцовых волн на АФМ
- У Использование упругих напряжений для изменения пороговых токов и частоты колебаний АФМ устройств
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# МОТИВАЦИЯ

 Нехватка методов и устройств для приёма и генерации терагерцового излучения (THz gap problem)



### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

пьезополупровод

ники и др.

	-				
Название	Среда передачи	Носители	Характерная длина волны	Частоты	Недостатки
Электроника	Металл, полупроводник	Электроны , дырки	2,42·10 <sup>-6</sup> мкм	ΓΓц, ΤΓц	Омические потери, топология межсоединений
Фотоника	диэлектрик	Фотоны, ЭМВ	0.5-10 мкм	40-700 ТГц	Управляемость, масштабируемость
Плазмоника	Диэлектрик- металл	Плазмоны	0.1-1 мкм	ТГц	Затухание, скин-эффект
Спинтроника	Магнетик-металл- диэлектрик	Электроны , спиновые волны	2,42·10 <sup>-6</sup> мкм 0.1-∞ мкм	ГГц	Повторяемость
Магноника	Ферромагнетики, Антиферромагне- тики, слоистые магнитные структуры	Магноны	0.1-∞ мкм	до 100 ГГц, ТГц	Необходимо внешнее магнитное поле для ФМ, повторяемость
Акустоэлектроника	Пьезоэлектрики,	Фононы	мм	МГц,	Диапазон частот, высокие

единицы

ΓГц

потери при

распространении

### ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СТРЕЙНТРОНИКИ



1,2 – пьезомагнитный эф-т и магнитострикция
3,4 – пьезоэлектрический эф-т и электрострикция
5,6 – магнитоэлектрический (лин и нелин по М)
7,8 – флексомагнитные эф-ты (прямой и обратный)
9,10 – флексоэлектрич. эф-ты (прямой и обратный)
11,12 – флексомагнитоэлектрич. эф-ты (прям. и обратн.)



Бухараев А.А. и др., УФН. 2018.

# ЭЛЕКТРОНИКА и СПИНТРОНИКА

Заряд

Спин

Основана на переносе <u>заряда</u> носителей электрического тока.

Основана на переносе собственного магнитного момента - <u>спина</u> носителей электрического тока.



Спинтроника

Электроника \_\_\_\_\_

В немагнитном проводнике электроны рассеиваются независимо от направления спина. От среднего количества рассеяния электронов зависит электрическое сопротивление проводника.



В ферромагнитном проводнике электроны рассеиваются по-разному в зависимости от направления спина электронов. Например, электроны со спином вверх рассеиваются сильнее, чем со спином вниз.



### ГИГАНТСКОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ

Ферромагнитные слои с противоположными направлениями намагниченностей слоев останавливают электроны обоих направлений спина.





### плотность записи информации



### ЭФФЕКТ ПЕРЕНОСА СПИНА



Уравнение Ландау-Лифшица-Гильберта (для намагниченности свободного слоя)

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \left[ \gamma \left[ \mathbf{H}_{eff} \times \mathbf{M} \right] + \frac{\alpha}{M_0} \left[ \mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} \right] + \frac{\alpha_I}{M_0} \left[ \mathbf{M} \times \left[ \mathbf{M} \times \mathbf{p} \right] \right] \right]$$

$$\mathbf{\Pi} \mathbf{p} \mathbf{e} \mathbf{q} \mathbf{e} \mathbf{c} \mathbf{u} \mathbf{g}$$

$$\mathbf{n} \mathbf{p} \mathbf{e} \mathbf{q} \mathbf{e} \mathbf{c} \mathbf{u} \mathbf{g}$$

$$\mathbf{n} \mathbf{p} \mathbf{e} \mathbf{q} \mathbf{e} \mathbf{c} \mathbf{u} \mathbf{g}$$

$$\mathbf{n} \mathbf{p} \mathbf{e} \mathbf{q} \mathbf{e} \mathbf{c} \mathbf{u} \mathbf{g}$$

<u>момента (spin torque)</u>

## СПИНОВЫЙ ЭФФЕКТ ХОЛЛА И СПИНОВАЯ НАКАЧКА



АС и DC сигналы за счет обратного спинового эффекта Холла Wei, D., et al., 2014, Nat. Commun. 5, 3768. Normal metal Charge current Spin current

Эффект возникает из-за анизотропии рассеяния электронов с разными направлениями спинов на примесях немагнитного металла вследствие спинорбитального взаимодействия.

Обратный спиновый эффект Холла. При пропускании спин-поляризованного тока регистрируют напряжение ~10 нВ.

Дьяконов М.И., Перель В.И. 1971. Письма в ЖЭТФ. 13(11). С. 657-660.

### ОСЦИЛЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ СПИНОВОГО ЭФФЕКТА ХОЛЛА



Рис.1. Конструкция СХНО, управляемого током





Рис.2. Зависимость частоты колебаний от постоянного тока



M. Dvornik, A. A. Awad, and J. Åkerman Phys. Rev. Appl. **9**, 014017 (2018)

### ЛОКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ БОЛЬШИХ МАССИВОВ СХНО

#### Линейка из 21 осциллятора





#### Решетка из 64 и 100 осцилляторов





M. Zahedinejad, et al. ArXiv:1812.09630v1.

### ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МОЩНОСТИ И ШИРИНЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ОСЦИЛЛЯТОРОВ



### МАГНОНИКА



• Резонаторы

#### Примеры реализации 1D-магнонных кристаллов







## МАГНОННАЯ СТРЕЙНТРОНИКА





# АФМ & ТГЦ спинтроника





Электрическое переключение АФМ полупроводников

P. Wadley, et al. Science 2016



T. Kampfrath, et al. Nat.Phot. 2011



16

# АФМ Спин-Холл Наноосциллятор



17

# АФМ ДИНАМИКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА



d**¢**∕dt [a.u.]



#### Критические токи:







# ВНЕШНЯЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

#### Field-like Neel spin-orbit torque (NSOT):

 $\tau_{\scriptscriptstyle NSOT} \sim \mathbf{l} \times \mathbf{n} \times \mathbf{j}$ 

### Was discovered in metallic AFMs with broken inversion symmetry

Narrow-band tunable THz detector in antiferromagnets via Néel spin-orbit torque and spin-transfer torque

O. Gomonay,<sup>1,2</sup> T. Jungwirth,<sup>3,4</sup> and J. Sinova<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Institut für Physik, Johannes Gutenberg Universität Mainz, D-55099 Mainz, Germany <sup>2</sup>National Technical University of Ukraine "KPI", 03056, Kyiv, Ukraine <sup>3</sup>Institute of Physics ASCR, w.ii., Cukrovarnicka 10, 162 53 Praha 6 Czech Republic <sup>4</sup>School of Physics and Astronomy, University of Nottingham, Nottingham NG7 2RD, United Kingdom



O. Gomonay, et al. PRB. 2018.

Anti-damping-like torque:

 $\tau_{STT} \sim j(\mathbf{l} \times \mathbf{p} \times \mathbf{l})$ 

p<sub>ac</sub> along Hard-axis

**p**<sub>ac</sub> || **p**<sub>dc</sub> || **H**<sub>HA</sub>



Easy plane

#### Efficient injection-locking via parallel pumping



R. Khymyn, et al. INTERMAG. 2017.

## Взаимная синхронизация АФМО





## ГЕНЕРАТОРЫ С ВНЕШНИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ





# СТРУКТУРА ДЕТЕКТОРА



Построение наноразмерного, резонансного, перестраиваемого током детектора ТГц электромагнитных волн.

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ





# ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



# ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Изменение угла внешнего магнитного поля позволяет добиваться

#### увеличения интенсивности мод



МОЖНО добиваться увеличения мощности в резонансе путем подбора величины и направления поля подмагничивания!

## МАГНИТОУПРУГОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Магнитоупругая связь





## МАГНИТОУПРУГОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вызванные явления:

1. Пьезомагнитные эффекты



2. Магнитоупругие волны

# ИССЛЕДУЕМАЯ СТРУКТУРА



# МАГНИТНАЯ ДИНАМИКА

Уравнение динамики для исследуемой системы

$$\frac{\ddot{\phi}}{\omega_{ex}} + \alpha \dot{\phi} + \omega_e \frac{\sin 2\phi}{2} - \sigma j = 0$$

 $\phi$  - азимутальный угол намагниченности

- $\omega_{ex} =$  гиромагнитное отношение × обменное поле
- $\alpha$  параметр затухания
- $\omega_e$  = гиромагнитное отношение × поле анизотропии
- $\sigma$  коэффициент вклада в динамику от тока
- j плотность тока в платине

Магнитоупругое взаимодействие позволяет управлять величиной  $\omega_e$ 

# РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ



# РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ



График зависимости частоты колебаний от поля Epz при разных

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ



Зависимость порогового тока (левая ось) и амплитуды генерации (правая ось) от поля Ерг на пьезоэлектрике

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Использование упругих деформаций позволяет менять эффективное поле анизотропии антиферромагнетика, приводя к контролю частоты колебаний АФМ осцилляторов и детекторов терагерцового диапазона частот.
- Подстройка частоты колебаний детектора терагерцовых колебаний может осуществляться изменением подведенного напряжения на пьезоэлектрик (без использования постоянного спинполяризованного тока высокой плотности).

### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

### 2. Связь поля и анизотропии

1. Пьезоэлектрический эффект  $e_{ij}^{PZ} = d_{kij}E_k$ 

2. Идеальный акустический контакт на границе PZ-AFM, Свободная граница Pt-AFM и закон Гука :

$$e_{ij}^{IF} = P_{ik}e_{kl}^{PZ}P_{lj} = P_{ik}e_{kl}P_{lj}$$
,  
 $\sigma_{ij}n_i = 0$ ,  
 $\sigma_{ij} = C_{ijkl}e_{kl}$   
 $P_{ij}$  – проектор на границу РZ-АFM  
 $\bullet e_{ij} = G_{ijkl}d_{mkl}E_m$  - уравнение деформации в  
антиферромагнетике

 $G_{ijkl}$  зависит от взаимной ориентации пьезоэлектрика и антиферромагнетика и от их материальных констант.

### 2. Связь поля и анизотропии

Индуцированное магнитоупругое поле:

Из выражения для магнитоупругой энергии

 $E^{ME} = R_{ijkl} M_i M_j e_{kl}$ 

Магнитоупругое поле можно найти как

$$B_i^{ME} = -\frac{\partial E^{ME}}{\partial M_i} = -2R_{ijkl}M_je_{kl}$$
$$= -2R_{ijkl}M_jG_{klmn}d_{smn}E_s = K_{ijs}M_jE_s$$

Вид собственного поля анизотропии:

 $B^e_i = -\frac{B^e}{M^s} n^e_i n^e_j M_j$ 

Возможно так подобрать  $K_{ijs}$ , что  $B_i^{ME}$  будет сонаправлен с  $B_i^e$ ,